Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0402U002364

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-07-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кавецький Тарас Степанович
2. Kavetskyy Taras Stepanovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCHID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 19-06-2002

Спеціальність за освітою: 7.010103

Місце роботи здобувача: Науково-виробниче підприємство "Карат"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження: 79031, м. Львів, вул. Стрийська, 202

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство промислової політики України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 35.051.09

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в халькогенідних склоподібних напівпровідниках потрійної системи Ge-Sb-S

2. Compositional peculiarities of radiation-induced phenomena in chalcogenide vitreous semiconductors of Ge-Sb-S ternary system

Реферат:

1. Радіаційно-індуковані явища в халькогенідних склоподібних напівпровідниках (ХСН). Дослідити композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в ХСН потрійної системи Ge-Sb-S та відшукати адекватні аналітичні співвідношення для їх інтерпретації. Методами дослідження є методи оптичної спектрофотометрії та метод вимірювання мікротвердості по Віккерсу. Встановлено ефект радіаційно-індукованого потемніння, який містить динамічну та статичну складові, є максимальним в ХСН, збагачених Ge, і повністю відсутнім в ХСН, збагачених Sb. Концепція вільного об'єму є найбільш адекватною для інтерпретації спостережуваних явищ. Сферою використання є ІЧ техніка, оптоелектроніка.

2. Radiation-induced phenomena in chalcogenide vitreous semiconductors (ChVS). To investigate compositional peculiarities of radiation-induced phenomena in ChVS of Ge-Sb-S ternary system and to find adequate analytical correlations for their interpretation. Methods of research are the methods of optical spectroscopy and method of

measurement of Vickers Hardness. The radiation-induced darkening effect, which consisting of dynamic and static components and is larger in Ge-rich ChVS and completely absents in Sb-rich ChVS, is established. The free volume concept is the most adequate for interpretation of the observed phenomena. Sphere of use is the IR optics, optoelectronics.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Луців Р.В.
2. Lutsiv R.V.

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCHID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Блецкан Д.І.
2. Блецкан Д.І.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCHID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Половинко І.І.
2. Половинко І.І.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCHID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Вакарчук І.О.
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Вакарчук І.О.
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

Юрченко Т.А.